

# Silicon FET Transistor

## **KP303**

10V

# DATASHEET

OEM – CCCP

Source: Datasheet



## 3.3. Допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра,	н о р м а	
	KP303A ÷ И	
Максимально допустимое напряжение затвор-исток, V, при $t_{amb} = 233K \div 358K$	30	
Максимально допустимое напряжение затвор-сток, V, при $t_{amb} = 233K \div 358K$	30	
Максимально допустимое напряжение сток-исток, V, при $t_{amb} = 233K \div 358K$	25	
Максимально допустимый постоянный ток стока, mA, при $t_{amb} = 233K \div 358K$	20	
Максимально допустимый прямой ток затвора, mA, при $t_{amb} = 233K \div 358K$	5	
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, mW, при $t_{amb} = 298K$	200	
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, mW, при $t_{amb} = 358K$	100	

## 4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Разрешается соединение транзистора с элементами аппаратуры на расстоянии не менее 4 мм от корпуса транзистора различными способами пайки, исключая нагревание в месте пайки свыше 533 К.

Пайку производить в течение времени, не превышающего 3 с.

При пайке обязательно применение мер, предохраняющих корпус транзистора от попадания флюса и припоя.

Разрешается производить пайку путем погружения выводов не более чем на 3 с в расплавленный припой с температурой не выше 533 К.

4.2. При эксплуатации транзисторов в условиях механических воздействий  $> 2g$  их необходимо крепить за корпус.

Минимальное расстояние места изгиба вывода от корпуса транзистора 3 мм, радиус изгиба — не менее 1,5 мм.

Допускается однократный изгиб вывода на расстоянии 3 мм от корпуса с радиусом изгиба 0,5 мм.

4.3. Допускается однократное использование транзисторов группы KP303 Г при температурах до 123 К.

4.4. При повышенной влажности с целью обеспечения тока утечки затвора на уровне не выше  $10^{-7}$  А рекомендуется использовать транзисторы в составе герметизированной аппаратуры или при местной защите прибора от воздействия влаги.

4.5. Допускается применение транзисторов, изготовленных в обычном климатическом исполнении, в аппаратуре, предназначенной для эксплуатации во всех климатических условиях при покрытии транзисторов непосредственно в аппаратуре лаками (в 3—4 слоя) с последующей сушкой.

## 5. ХРАНЕНИЕ

Транзисторы следует хранить в отапливаемых (или охлаждаемых) и вентилируемых складах при температуре от 278 К до 308 К и относительной влажности воздуха до 85%.

Транзисторы соответствуют техническим условиям.

Место для  
штампа ОТК **ОТК-3**

Место для штампа  
представителя заказчика.  
Зак. № 132, тир. 1,500 — 85 г.